

# Photodiode JE1P



- Charakteristik :
- ◆ Spektralbereich 400 ... 1100 nm
  - ◆ strahlungsempfindliche Fläche (1 x 1) 1 mm<sup>2</sup>
  - ◆ hochwertige Si - PIN - Photodiode mit erhöhter IR - Empfindlichkeit, niedrigem Dunkelstromniveau, hohem Nullpunktwidestand und hoher spektraler Empfindlichkeit
  - ◆ hermetisches TO-46 Gehäuse mit sehr flachem Glasfenster

- Applikationen :
- ◆ universeller Detektor für lichttechnische und nichtoptische Anwendungen ( $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  - Detektion)

Grenzwerte:

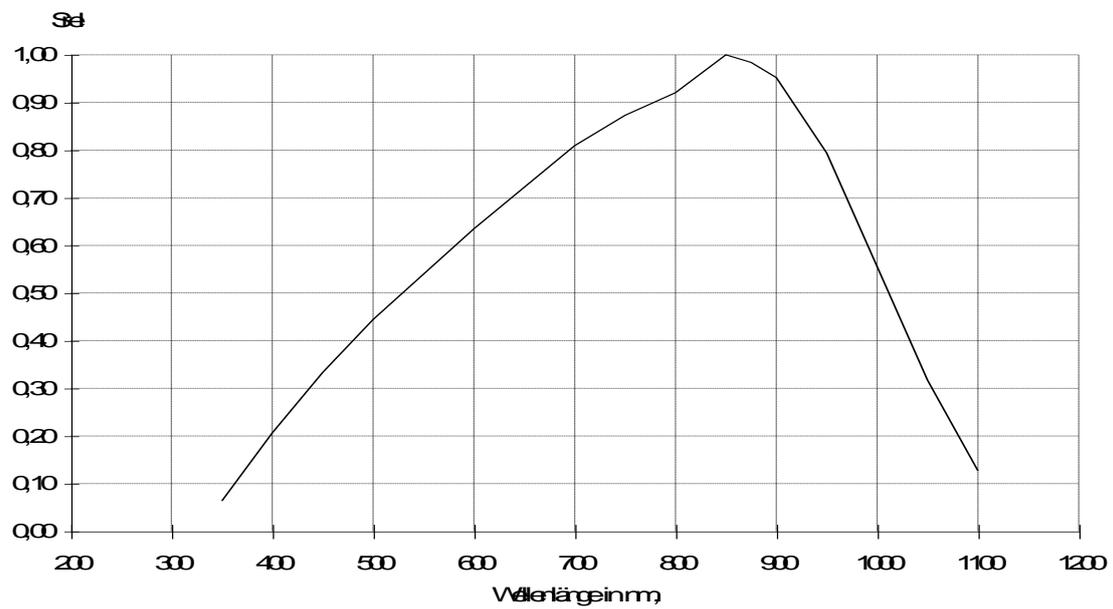
Sperrspannung	20	V
Betriebstemperaturbereich	- 25 °C ... 80	°C
Lagertemperaturbereich	- 40 °C ... 100	°C
Löttemperatur (3s)	260	°C

Technische Daten :

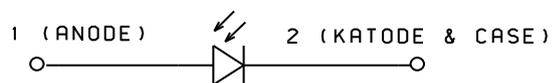
Allgemeine Meßbedingungen, sofern nicht anders spezifiziert:  $\gamma_a = 23 \text{ °C}$ ,  $V_R = 0V$

Parameter	Meßbedingung	min.	typ.	max.	Einh.
strahlungsempfindliche Fläche A			1		mm <sup>2</sup>
Max. der spektralen Empfindlichkeit $S_{max}$ bei			950		nm
Spektralbereich $\lambda_{min}$ $\lambda_{max}$	$S = 0,1 \cdot S_{max}$		400 1100		nm
absolute spektrale Empfindlichkeit	$\lambda = 950 \text{ nm}$		0,62		A/W
Dunkelstrom $I_R$	$V_R = 5V$ $E = 0 \text{ lx}$		1		nA
Nullpunktwidestand			500		M $\Omega$
Anstiegszeit Abfallzeit des Fotostromes	$R_L = 1k\Omega$ $\lambda = 830 \text{ nm}$ $V_R = 5V$		30		ns
Kapazität	$f = 1 \text{ MHz}$ $E = 0 \text{ lx}$		40		pF

## Relative spektrale Empfindlichkeit



## Innenschaltung



## Gehäuseabmessungen

